

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 10 日 (10.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/022609 A1

(51) 国際特許分類: H01L 21/02, 21/304, 21/68, C09J 7/02

Shinichi) [JP/JP]; 〒4570801 愛知県名古屋市中区丹後通 2-1 三井化学株式会社内 Aichi (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/012506

(22) 国際出願日: 2004 年 8 月 31 日 (31.08.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-308174 2003 年 9 月 1 日 (01.09.2003) JP
特願 2003-394836
2003 年 11 月 26 日 (26.11.2003) JP

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057117 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 才本 芳久 (SAIMOTO, Yoshihisa) [JP/JP]; 〒4570801 愛知県名古屋市中区丹後通 2-1 三井化学株式会社内 Aichi (JP). 片岡 真 (KATAOKA, Makoto) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0-3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 五十嵐 康二 (IGARASHI, Kouji) [JP/JP]; 〒4570801 愛知県名古屋市中区丹後通 2-1 三井化学株式会社内 Aichi (JP). 早川 慎一 (HAYAKAWA,

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ADHESIVE FILM AND METHOD FOR FORMING METAL FILM USING SAME

(54) 発明の名称: 粘着フィルムおよびそれを用いたメタル製膜方法

(57) Abstract: Disclosed is an adhesive film for preventing damages to a side of a semiconductor wafer on which no metal film is formed during formation of a metal film. This adhesive film also enables to reduce contamination on the front surface of the wafer. The adhesive film is obtained by forming an adhesive layer on one side a base film which is composed of at least one layer of a film having a gas permeability of not more than 5.0 cc/m²·day·atm. By protecting the side on which no metal film is formed with this adhesive film, a cleaning step using a solvent can be omitted and contamination of the side on which no metal film is formed can be reduced, thereby improving productivity and workability.

(57) 要約: 本発明は、半導体ウエハのメタル製膜時のメタル非製膜面の損傷を防止し、ウエハ表面の汚染の低減も図ることのできる粘着フィルムに関する。ガス透過度が 5.0 cc/m²·day·atm 以下であるフィルムが少なくとも 1 層積層された基材フィルムの片表面に粘着剤層が形成された粘着フィルムで、メタル非製膜面を保護することにより、溶剤による洗浄工程を省くことができ、更にメタル非製膜面の汚染性の低減も図ることのでき、生産性、作業性が向上する。

WO 2005/022609 A1